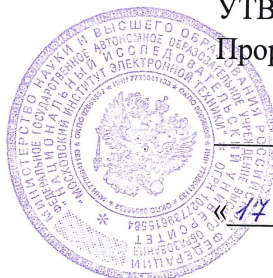


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР МИЭТ



А.Г. Балашов

А.Г. Балашов

«17» января 2025 г.

Программа вступительных испытаний
по приему в магистратуру в 2025 году
Института интегральной электроники имени академика К.А. Валиева
по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
по совокупности образовательных программ
«Проектирование приборов и систем»,
«Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники»
(очная форма обучения)

Москва 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень магистратуры) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 959.

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере эксплуатации электронных средств).

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:

- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская;
- научно-педагогическая.

При разработке и реализации программы магистратуры МИЭТ ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.

1.4. Поступающий должен предоставить в установленные Университетом сроки комплект документов, определенный Правилами приема в магистратуру МИЭТ, подтверждение индивидуальных достижений, пройти вступительные испытания для выявления уровня компетенций.

1.5. Максимальная суммарная балльная оценка ответа на вступительных испытаниях составляет 75 баллов.

1.6. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не должна превышать 100 баллов.

1.7. При поступлении в магистратуру учитываются индивидуальные достижения за 2021-2025 годы.

1.8. Индивидуальные достижения могут быть учтены только один раз.

1.9. Максимальное количество баллов, набранных по совокупности вступительных испытаний и индивидуальных достижений – 100 баллов.

1.10. Форма проведения вступительного испытания: собеседование.

1.11. Согласно Правилам приема в магистратуру МИЭТ в 2025 году участие в конкурсе принимают абитуриенты, набравшие по результатам вступительных испытаний не менее 25 баллов.

2. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

2.1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых комиссией.

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» в 2025 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры при поступлении на образовательные программы «Проектирование приборов и систем» и «Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники» Института

интегральной электроники имени академика К.А. Валиева по направлению 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника» установлены максимальные количества баллов за каждое индивидуальное достижение:

№ п/п	Наименование ИД	Оценка ИД	Документы для подтверждения наличия ИД
1.	Наличие диплома (бакалавра, специалиста) с отличием	10 баллов	Копия (или подлинник) диплома
2.	Победитель / призер проводимого МИЭТ конкурса творческих и проектных работ по профилю направления подготовки магистратуры	100 / 75 баллов	Диплом победителя / Диплом призера
3.	Победитель / призер или лауреат / участник Международного или Всероссийского конкурса (выставки) научных и творческих работ, Международной или Всероссийской студенческой олимпиады (чемпионата) по профилю направления подготовки магистратуры	100 / 75 / 10 баллов	Диплом победителя / Диплом призера или лауреата / Сертификат участника
4.	Письменное согласие организации о предоставлении места практики с указанием тематики профессиональной деятельности, соответствующей профилю направления подготовки магистратуры	До 10 баллов	Письмо на официальном бланке организации или протокол предварительного согласования
5.	Наличие научных публикаций по профилю направления подготовки магистратуры или РИД	До 10 баллов	Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст публикации, выходные данные)
	статья в сборнике трудов/сборнике тезисов конференций	до 3 баллов	
	статья в сборнике трудов конференций или журнале с индексацией в системе РИНЦ	до 5 баллов	
	статья в журнале, включенном в перечень ВАК или в международные базы цитирования; патент, свидетельство о регистрации топологии (программы, полезной модели), заявка на изобретение.	до 10 баллов	
6.	Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию не ниже 5 уровня в рамках профессиональных стандартов, соответствующих образовательной программе.	До 20 баллов	Диплом или сертификат
7.	Наличие диплома или сертификата о дополнительном образовании/ профессиональной переподготовке по профилю направления подготовки магистратуры	До 20 баллов	Диплом или сертификат

2.2. Дополнительные критерии оценивания индивидуальных достижений

Индивидуальные достижения оцениваются в день прохождения Поступающим вступительных испытаний. Оцениваются только представленные в Комиссию индивидуальные достижения на основе списка документов для подтверждения наличия индивидуальных достижений документов в соответствии с разделом 2.1.

В п. 3 могут учитываться Всероссийские конкурсы, выставки, олимпиады и чемпионаты, организованные ведущими вузами России. Комиссией устанавливается соответствие тематики конкурса или олимпиады направлению подготовки магистратуры.

Победители и призеры ежегодного Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную и научную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования (ВИК), при соответствии направления ВИК профилю направления подготовки, приравниваются к лицам, набравшим максимальные баллы как по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, так и за индивидуальные достижения.

В п. 5 могут учитываться:

- опубликованные научные статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК или в рецензируемых журналах, трудах конференций, входящих в международные базы цитирования;
- опубликованные статьи в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ);
- опубликованные материалы конференции или тезисы на конференциях, журналах включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также других конференциях;
- патент или заявка на изобретение или полезную модель по тематике направления подготовки.

Комиссией устанавливается соответствие области представленной научной публикации или РИД по тематике направлению подготовки магистратуры. За все индивидуальные достижения п.5 может быть выставлено не более 10 баллов суммарно.

3. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

3.1. Приём вступительного испытания в форме собеседования производится экзаменационной комиссией в соответствии с расписанием и списками поступающих, подготовленными приёмной комиссией.

3.2. Вступительные испытания по направлению 11.04.04 проводятся в форме собеседования в очной форме или посредством видеоконференцсвязи. К прохождению вступительных испытаний допускаются поступающие, подавшие все необходимые для проведения испытания документы.

3.3. Студенты, изъявившие желание пройти собеседование посредством видеоконференцсвязи должны не позднее 1 (одних) суток до проведения собеседования связаться с представителями образовательных программ по e-mail: ieem@miee.ru для согласования порядка проведения видеоконференцсвязи. Комиссия вправе назначить время и рекомендуемый канал связи для проведения видеоконференцсвязи. Поступающий

обязан предусмотреть возможность подтверждения своей личности во время проведения собеседования.

3.4. При возникновении особого режима, допускается проведение вступительных испытаний исключительно с использованием дистанционных технологий. Процедура проведения вступительных испытаний в случае возникновения особого режима устанавливается соответствующим регламентом Университета.

3.5. В ходе собеседования поступающий выступает с устным докладом (сопровождаемым презентацией в электронном и/или распечатанном виде), посвящённым предыдущему опыту научно-исследовательской или проектно-конструкторской работы. В докладе рекомендуется также привести краткие сведения об индивидуальных достижениях и сведения о предполагаемой тематике исследований в процессе обучения в магистратуре. Продолжительность устного доклада – 5-7 минут (без учёта времени для ответов на вопросы комиссии). По завершению доклада поступающий устно отвечает на вопросы экзаменационной комиссии по представленным материалам.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Результаты собеседования оцениваются по следующим трём критериям:

- научная и практическая значимость представленной работы – до 25 баллов,
- качество устного доклада и оформления презентации – до 25 баллов,
- качество ответов на вопросы – до 25 баллов.

4.2. Каждый член экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает результаты собеседования в соответствии с указанными критериями оценивания.

4.3. Итоговая оценка по каждому критерию рассчитывается как среднее арифметическое суммарных баллов, выставленных всеми членами комиссии при оценке результатов собеседования по данному критерию. Округление производится до ближайшего целого числа баллов. Числа с дробной частью 0,5 округляются в большую сторону.

4.4. Итоговая оценка по результатам собеседования определяется как сумма итоговых оценок по каждому критерию.

4.5. Комиссия по приему вступительных испытаний в течение одного дня после проведения экзамена передает протоколы с результатами вступительных испытаний в приемную комиссию.

Директор Института ИнЭл



В.В. Лосев

Руководители магистерских программ:

«Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники»


Ю.А. Чаплыгин

«Проектирование приборов и систем»


М.Г. Путря

«16» сентября 2025 г.